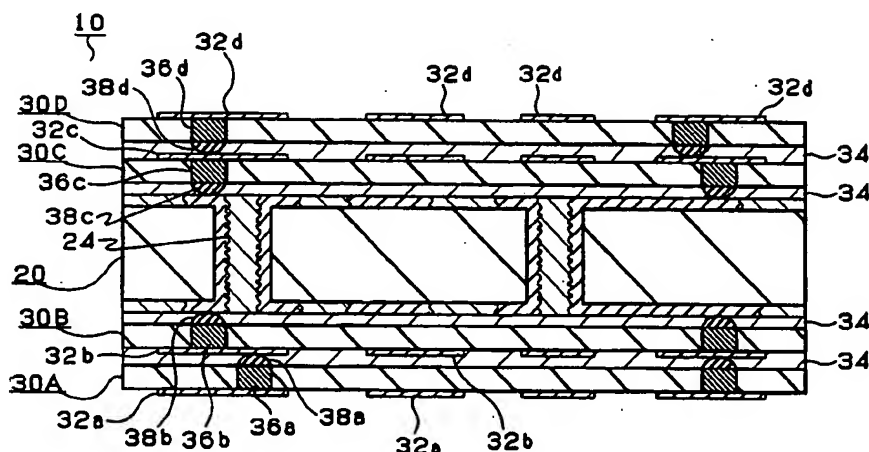




<p>(51) 国際特許分類6 H05K 3/46, 3/40</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO98/56220</p> <p>(43) 国際公開日 1998年12月10日(10.12.98)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP98/02498</p> <p>(22) 国際出願日 1998年6月5日(05.06.98)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平9/165291 1997年6月6日(06.06.97) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) イビデン株式会社(IBIDEN CO., LTD.)(JP/JP) 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gihu, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および</p> <p>(75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 榎本 亮(ENOMOTO, Ryo)(JP/JP) 平松靖二(HIRAMATSU, Yasuji)(JP/JP) 〒501-0601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1丁目1番地 イビデン株式会社 大垣北工場内 Gihu, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 田下明人, 外(TASHITA, Akihito et al.) 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル4階 Aichi, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 CN, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>

(54)Title: SINGLE-SIDED CIRCUIT BOARD AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54)発明の名称 片面回路基板およびその製造方法



(57) Abstract

Holes (40a) are formed with a laser beam through an insulating substrate (40) on which a metallic layer (42) is formed and via holes (36a) are formed by filling up the holes (40a) with a metal (46). After the via holes (36a) are formed, a conductor circuit (32a) is formed by etching the metallic layer (42) and a single-sided circuit board (30A) is formed by forming projecting conductors (38a) on the surfaces of the via holes (36a). The projecting conductors (38a) on the circuit board (30A) are put on the conductor circuit (32b) of another single-sided circuit board (30B) with adhesive layers (50) composed of an uncured resin in between and heated and pressed against the circuit (32b). The projecting conductors (38a) get in the uncured resin by pushing aside the resin and are electrically connected to the circuit (32b). Since single-sided circuit boards (30A, 30B, 30C, and 30D) can be inspected for defective parts before the boards (30A, 30B, 30C, and 30D) are laminated upon one another, only defectless single-sided circuit can be used in the step of lamination.

(57)要約

金属層（４２）が形成された絶縁基材（４０）に孔（４０ａ）をレーザー光にて形成する。該穴（４０ａ）に金属（４６）を充填してバイアホール（３６ａ）を形成する。そして、金属層（４２）をエッチングして導体回路（３２ａ）を形成する。バイアホール（３６ａ）の表面に突起状導体（３８ａ）を形成して片面回路基板（３０Ａ）とする。該片面回路基板（３０Ａ）の突起状導体（３８ａ）と他の片面回路基板（３０Ｂ）の導体回路（３２ｂ）を接着剤層（５０）である未硬化樹脂を介して積層し、加熱加圧する。突起状導体（３８ａ）は、未硬化樹脂の中に嵌入し樹脂を押し退け、導体回路（３２ｂ）と電氣的に接続する。ここで、片面回路基板（３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ）を積層する前に、導体回路等の不良個所の有無を検査することができるので、積層段階では、不良のない片面回路基板のみを用いることができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AL	アルバニア	FI	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SI	スロヴェニア
AM	アルメニア	FR	フランス	LR	リベリア	SK	スロヴァキア
AT	オーストリア	GA	ガボン	LS	レソト	SL	シエラ・レオネ
AU	オーストラリア	GB	英国	LT	リトアニア	SN	セネガル
AZ	アゼルバイジャン	GD	グレナダ	LU	ルクセンブルグ	SZ	スワジランド
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	TD	チャード
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BE	ベルギー	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BF	ブルキナ・ファソ	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BG	ブルガリア	CW	ギニア・ビサウ	MK	マケドニア	TR	トルコ
BJ	ベナン	GR	ギリシャ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
BR	ブラジル	HR	クロアチア	ML	マリ	UA	ウクライナ
BY	ベラルーシ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UG	ウガンダ
CA	カナダ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	US	米国
CC	中央アフリカ	IE	アイルランド	MW	マラウイ	UZ	ウズベキスタン
CG	コンゴ	IL	イスラエル	MX	メキシコ	VN	ヴェトナム
CH	スイス	IN	インド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラビア
CI	コートジボアール	IS	アイスランド	NL	オランダ	ZW	ジンバブエ
CM	カメルーン	IT	イタリア	NO	ノルウェー		
CN	中国	JP	日本	NZ	ニュージーランド		
CU	キューバ	KE	ケニア	PL	ポーランド		
CY	キプロス	KG	キルギスタン	PT	ポルトガル		
CZ	チェコ	KP	北朝鮮	RO	ルーマニア		
DE	ドイツ	KR	韓国	RU	ロシア		
DK	デンマーク	KZ	カザフスタン	SD	スーダン		
EE	エストニア	LC	セントルシア	SE	スウェーデン		
ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SG	シンガポール		



- 1 -

明細書

片面回路基板およびその製造方法

5 技術分野

この発明は、片面回路基板およびその製造方法に関し、特に、インターステシャルバイアホール（I V H）構造を有する多層プリント配線板の製造に使用される片面回路基板とその製造方法に関する。

10 背景技術

従来の多層プリント配線板は、銅張積層板とプリプレグを交互に積み重ねて一体化してなる積層体にて構成されている。この積層体は、その表面に表面配線パターンを有し、層間絶縁層間には内層配線パターンを有する。これらの配線パターンは、積層体の厚さ方向に穿孔形成したスルーホールを介して、内層

15 配線パターン相互間あるいは内層配線パターンと表面配線パターンとの間で電氣的に接続されている。

ところが、上述したようなスルーホール構造の多層プリント配線板は、スルーホールを形成するための領域を確保する必要があるために、部品実装の高密度化が困難であり、携帯用電子機器の超小型化や狭ピッチパッケージおよびM

20 CMの実用化の要請に十分に対処できないという欠点があった。

そのため、最近では、上述のようなスルーホール構造の多層プリント配線板に代えて、高密度化に対応し易い全層インターステシャルバイアホール（I V H）構造を有する多層プリント配線板が注目されている。

25 30 この全層I V H構造を有する多層プリント配線板は、積層体を構成する各層間絶縁層に、導体層間を電氣的に接続するバイアホールが設けられている構造のプリント配線板である。即ち、この配線板は、内層配線パターン相互間あるいは内層配線パターンと表面配線パターン間が、配線基板を貫通しないバイアホール（ベリードバイアホールあるいはブラインドバイアホール）によって電氣的に接続されている。それ故に、I V H構造の多層プリント配線板は、スルーホールを形成するための領域を特別に設ける必要がなく、任意の層間を微細

- 2 -

なバイアホールで自由に接続できるため、電子機器の小型化、高密度化、信号の高速伝搬を容易に実現することができる。

こうしたI V H構造の多層プリント配線板は、例えば、第6図に示すような工程によって製造されている。

- 5 まず、プリプレグ112としてアラミド不織布にエポキシ樹脂を含浸させた材料を用い、このプリプレグ112に炭酸ガスレーザによる穴開け加工を施し、次いで、このようにして得られた穴部分112aに導電性ペースト114を充填する（第6図（A）参照）。

- 10 次に、上記プリプレグ112の両面に銅箔116を重ね、熱プレスにより加熱、加圧する。これにより、プリプレグ112のエポキシ樹脂および導電性ペーストが硬化され両面の銅箔116、116相互の電氣的接続が行われる（第6図（B）参照）。

そして、上記銅箔116をエッチング法によりパターンニングすることで、バイアホールを有する硬質の両面基板が得られる（第6図（C）参照）。

- 15 このようにして得られた両面基板をコア層として多層化する。具体的には、上記コア層の両面に、上述の導電性ペーストを充填したプリプレグと銅箔とを位置合わせしながら順次に積層し、再度熱プレスしたのち、最上層の銅箔116をエッチングすることで4層基板を得る（第6図（D）、（E）参照）。さらに多層化する場合は、上記の工程を繰り返し行い、6層、8層基板とする。

- 20 しかしながら、上述した従来技術は、熱プレスによる積層工程とエッチングによる銅箔のパターンニング工程とを何度も繰り返さなければならず、製造工程が複雑になり、製造に長時間を要することである。

- 25 しかも、このような製造方法によって得られるI V H構造の多層プリント配線板は、製造過程で1個所でも（一工程でも）前記パターンニング不良が発生すると、最終製品である配線板全体が不良品となるために、歩留りが大幅に低下する。

本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、I V H構造の高密度多層プリント配線板を高い歩留りで効率よく製造することにある。

発明の開示

本発明に片面回路基板は、上記目的を達成するため以下のように構成できる。
絶縁性基材の一方の面に導体回路を形成してなり、かつ前記絶縁性基材には導
体回路に至る非貫通孔を設け、その非貫通孔に、電解めっきを充填してバイア
5 ホールを形成するとともに、前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側
のバイアホールの表面には、導電性ペーストあるいは低融点金属からなる突起
状導体を形成したことを技術的特徴とする。

本発明の好適な態様において、前記非貫通孔は、電解めっきにより完全に充
填されてなることを技術的特徴とする。

- 10 本発明の好適な態様において、前記非貫通孔は、電解めっきにより、平均で
その非貫通孔の深さの50%以上、100%未満充填されてなることを技術的
特徴とする。

本発明の好適な態様において、前記絶縁性基材は、有機系絶縁性基材である
ことを技術的特徴とする。

- 15 本発明の好適な態様において、前記電解めっきは、電解銅めっきであることを
技術的特徴とする。

本発明の好適な態様において、前記絶縁性基材は、片面銅張積層板であるこ
とを技術的特徴とする。

- 20 本発明は、以下の(1)～(4)の工程を少なくとも含むことを技術的特徴
とする片面回路基板の製造方法、

(1) 一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属層に至る非貫通
孔をレーザ加工にて形成する工程、

(2) (1)で形成された非貫通孔に電解めっきを充填してバイアホールを
形成する工程、

- 25 (3) 金属層をエッチングして導体回路を形成する工程、

(4) 前記絶縁性基材の導体回路を形成した面のバイアホール表面に導電性
ペーストあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成して片面回路基板とす
る工程。

- 30 本発明は、以下の(1)～(3)の工程を少なくとも含むことを技術的特徴
とする片面回路基板の製造方法、

- 4 -

(1) 一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属層に至る非貫通孔をレーザ加工にて形成する工程、

(2) (1) で形成された非貫通孔に電解めっきを充填してバイアホールを形成した後、前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側のバイアホール
5 表面に導電性ペーストあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成する工程、

(3) 金属層をエッチングして導体回路を形成して片面回路基板とする工程。

本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記(1)の工程において、一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、フィルムを貼付し、
10 該フィルムおよび絶縁性基材を貫通して該金属層に至る非貫通孔をレーザ加工にて形成することを技術的特徴とする。

本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記絶縁性基材は、有機系絶縁性基材であることを技術的特徴とする。

本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記絶縁性基材は、片面銅張積層板であることを技術的特徴とする。

15 本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記電解めっきは、電解銅めっきであることを技術的特徴とする。

本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記突起状導体は、導電性ペーストを印刷することにより形成することを技術的特徴とする。

20 本発明の片面回路基板の製造方法は、好適な態様において、前記突起状導体は、低融点金属ペーストの印刷、低融点金属のめっき、または低融点金属の溶融液への浸漬により形成することを技術的特徴とする。

本発明の片面回路基板は、所定の配線パターンを形成した導体回路を有する片面回路基板として、予め個々に製造され、これらの片面回路基板は接着剤層を介して他の基板と積層され、熱プレスにより一体化される。このため、該片面回路基板は積層する前に、導体回路等の不良個所の有無を検査することか
25 できるので、積層段階では、不良のない片面回路基板のみを用いることが可能となる。即ち、製造段階での不良発生が少なくなり、I V H構造の多層プリント配線板を高い歩留まりで製造できる。

30 また、本発明の片面回路基板を使用してI V H構造の多層プリント配線を製造することにより、従来技術のようにプリプレグを積み重ねながら熱プレスを

- 5 -

繰り返す必要がない。即ち、本発明では、複数枚の片面回路基板を、該片面回路基板に配設された接着剤を介して重ね、1度に熱プレスすることかできる。このため、本発明によれば、複雑な熱プレスによる積層工程とパターンニング工程を繰り返す必要がなく、I V H構造の多層プリント配線板を短時間で効率良く製造することができる。

本発明においては、有機系絶縁性基板の非貫通孔の形成は、レーザ加工により行うのであるが、本願発明の構成では、有機系接着剤層にレーザ加工で孔明けする必要がなく、有機系絶縁性基板と接着剤層を同時にレーザ加工で孔明けしなくともよい。つまり、有機系絶縁性基板をレーザ加工で孔明けした後、片面回路基板もしくは導体回路を有する基板に有機系接着剤層を形成できるのである。

換言するならば、本発明の片面回路基板は、熱プレス時に有機系接着剤層へ嵌入貫通し、導体層間を接続するための突起状導体を有し、このため、接着剤層に予め導通のための孔明けをする必要がなく、絶縁性基材と有機系接着剤層は最終的な熱プレス工程時に存在していればよい。このため、孔明け後のデスマリア処理を有機系接着剤層の形成前に実施することができることになり、デスマリア処理により接着剤層が浸食されることがない。

また、絶縁性基板に非貫通孔を形成し、電解めっきで充填した後に、片面回路基板もしくは導体回路を有する基板に接着剤層を形成するため、電解めっき液とこの接着剤層が接触することはない。従って、めっき液により接着剤層が浸食されたり、汚染されることがない。

接着剤層は、最終工程の熱プレスに至るまでは未硬化であるため、デスマリア処理やめっき液で劣化しやすいが、本願発明では、このような問題の発生を防止し、信頼性の高い基板を容易に形成できるという特徴がある。

また、本発明の片面回路基板の導体回路を形成した面の反対側のバイアホール表面に形成された突起状導体は導電ペーストあるいは低融点金属であるため、熱プレスの際に導電ペーストあるいは低融点金属が変形して電解めっきの高さのばらつきを吸収することができ、接続不良を防止して接続信頼性に優れた多層プリント配線板を得ることができる。

また、本発明の片面回路基板は、接着剤層に予め導通のための孔を形成して

- 6 -

おく必要はなく、接着剤層の孔と絶縁基板に設けた突起状導体との位置ずれにより導通不良を起こすことがない。

さらに、本発明の片面回路基板では、電解めっきで充填されたバイアホール上に突起状導体を形成するため、多層プリント配線板における上下導体層の層間の電気的な接続は、比較的薄い有機系接着剤層のみを貫通させて行えば足りる。それ故、突起状導体の高さを低く、またその径を小さくできるため、突起状導体のピッチ間隔を小さくできるので、バイアホールのピッチ間隔も小さくなり、高密度化に対応できる。なお、バイアホールが電解めっきで充填されるため、上下導体層間の抵抗を低くできる。

- 10 なお、多層プリント配線板の樹脂絶縁層を貫通させて上下導体層間を接続する技術は、特開平7-14628号公報、特開平7-106756号公報、特開平7-231167号公報、特開平8-172270号公報、特開平8-288649号公報などに開示が見られるが、これらの技術は、いずれも電解めっきによる充填がされたバイアホール上に突起状導体を形成する技術ではなく、
- 15 本発明のような効果を奏することはない。

図面の簡単な説明

第1図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板の縦断面図である。

- 20 第2図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板を構成するコア基板の製造工程図である。

第3図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板を構成する片面回路基板の製造工程図である。

第4図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板を構成する片面回路基板の製造工程図である。

- 25 第5図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板の製造工程図である。

第6図は、従来技術に係る多層プリント配線板の製造工程図である。

第7図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板を構成するコア基板の製造工程図である。

- 30 第8図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板を構成するコア基板の製造工程図である。

- 7 -

第9図は、発明の一実施態様に係る多層プリント配線板のビアホール断面の金属構造を示す拡大写真である。

発明を実施するための最良の形態

5 以下、本発明の実施態様に係る片面回路基板、片面回路基板を用いた多層プリント配線板およびそれらの製造方法について図を参照して説明する。

第1図は、全層I.V.H構造を有する多層プリント配線板の縦断面を示している。多層プリント配線板10は、中央に配設されたコア基板20と、該コア基板20の上面及び下面に2層ずつ配設された本発明の片面回路基板30A、30B、30C、30Dとから成るビアホールを有する多層プリント配線板である。

該片面回路基板30A、30B、30C、30Dの一方の面には、所定のパターンの導体回路32a、32b、32c、32dが形成されており、他方の面には、接着剤層34が配設されている。該接着剤層34を介して、コア基板20と片面回路基板30A、30B、30C、30Dとが接着されている。各片面回路基板30A、30B、30C、30Dには、電解銅めっきにより充填形成されたビアホール36a、36b、36c、36dが形成されており、該ビアホールの上部（該導体回路が形成された面の反対側のビアホール表面）には、ハンダやインジウム合金などの低融点金属、あるいは導電性ペーストから成る突起状導体（以下バンプという）38a、38b、38c、38dが形成されている。

即ち、多層プリント配線板10においては、最下層の片面回路基板30Aの導体回路32aは、ビアホール36aを介してバンプ38aに接続されている。該バンプ38aは、片面回路基板30Bの導体回路32bと当接し、両者の接続を取る。該導体回路32bとビアホール36bを介して接続されたバンプ38bは、コア基板20のスルーホール24（多層化された後はビアホールとなる）と接触し、導通が取られている。該コア基板20のスルーホール24は、上面側の片面回路基板30Cのバンプ38cと接続されている。該バンプ38cとビアホール36cを介して接続された導体回路32cは、最上面の片面回路基板30Dのバンプ38dと接続されている。該バンプ38dは、

バイアホール 36 d を介して導体回路 32 d と接続されている。該最上面の片面回路基板 30 D の片面又は両面には、ベアチップ等の電子部品を搭載できる。このように、多層プリント配線板の最下層の片面回路基板 30 A の導体回路 32 a と、最上層の片面回路基板 30 D の導体回路 32 上のチップ部品（図示せず）とが、バイアホール 36 a、36 b、36 c、36 d を介して接続されている。これらのバイアホールは、インターステシャルバイアホールを構成する。

引き続き、本発明の片面回路基板を用いた多層プリント配線板 10 の製造方法について説明する。ここでは、先ず、コア基板 20 の製造方法について第 2 図を参照して述べる。

10 コア基板としては、ガラス布基材エポキシ樹脂基板、ガラス布基材 BT（ビスマレイミドトリアジン）樹脂基板などのリジッド基板であれば、公知のものを使用することができる。

具体的には、第 2 図の工程（A）に示すようにガラス布基材 BT（ビスマレイミドトリアジン）樹脂製の基板 22 の両面に銅箔 21 を貼付た銅張積層板を出発材とする。工程（B）に示すように、該基板 22 にスルーホール用の穴 22 a を穿設した後、無電解めっき処理を施し、該穴 22 a 内に銅めっきを施すことによりスルーホール 24 を形成する。

15 工程（C）に示すように、予め図示しないエッチングレジストを塗布した後、エッチング処理を施し、銅箔 21 の不要部分を除去することで、所定の導体回路 25 を形成する。

20 工程（D）に示すよう、該導体回路 25 及びスルーホール 24 の表面に黒化還元処理を施して粗化する。

25 工程（E）に示すように、充填樹脂 26 をロールコートにより均一に塗布し、該充填樹脂を硬化させた後、該充填樹脂をベルトサンダー等で導体回路 25 が表面に露出するまで研磨し、両面が平坦なコア基板 20 を製造する。

該コア基板 20 は、スルーホール 24 の内部、及び、導体回路 25 の側面 25 a が粗化され、導体回路 25 と充填樹脂 26 との接着性が改善されている。このため、該導体回路 25 と充填樹脂 26 との界面を起点として第 1 図を参照して上述した接着剤層 34 で、クラックの発生するのを防止できる。

30 引き続き、第 3 図、第 4 図を参照して本発明の片面回路基板 30 の製造方法

- 9 -

について説明する。第3図の工程(A)に示すように、片面に金属層42の形成された絶縁基材40を出発材とする。ここで、使用する絶縁基材40としては、有機系絶縁性基材であれば使用でき、具体的には、アラミド不織布-エポキシ樹脂基材、ガラス布エポキシ樹脂基材、アラミド不織布-ポリイミド基材、
5 ビスマレイミドトリアジン樹脂基材から選ばれるリジッド(硬質)の積層基材、あるいは、ポリフェニレンエーテル(PPE)フィルム、ポリイミド(PI)などのフィルムからなるフレキシブル基材から選ばれる1種であることが望ましい。

前記絶縁基材40としてはリジッドな積層基材であることが望ましく、特に
10 片面銅張積層板であることが好適である。金属層42がエッチングされた後の取扱中に配線パターンやビアホールが位置がずれることがなく、位置精度に優れるからである。

また、絶縁基材40に形成された金属層42は、銅箔を使用できる。銅箔は密着性改善のため、マット処理されていてもよい。ここでは、片面銅張積層板
15 を使用する。片面銅張積層板は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ビスマレイミド-トリアジン樹脂などの熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸させてBステージとしたプリプレグと銅箔を積層して熱プレスすることにより得られる基板である。片面銅張積層板は、リジッドな基板であり、扱いやすくコスト的にも最も有利である。また、絶縁基材40の表面に、金属を蒸着した後、電解めっきを用い、金属層を形成することもできる。
20

絶縁基材40の厚さは10~200 μ m、好ましくは15~100 μ mであり、20~80 μ mが最適である。絶縁性を確保するためである。これらの範囲より薄くなると強度が低下して取扱が難しくなり、逆に厚すぎると微細なビアホールの形成および導電性材料による充填が難しくなるからである。

25 一方、金属層42の厚さは、5~35 μ m、好ましくは8~30 μ mであり、12~25 μ mが好適である。これは、後述するようにレーザ加工にて孔明けした際に、薄すぎると貫通してしまうからであり、逆に厚すぎるとエッチングにより、ファインパターンを形成し難いからである。

ついで、レーザ加工により、絶縁基材40に非貫通孔40aを開ける(工程
30 (B))。レーザ加工機としては、炭酸ガスレーザ加工機、UVレーザ加工機、

- 10 -

エキシマレーザ加工機などを使用できる。また、孔径は20～150 μm がよい。炭酸ガスレーザ加工機は、加工速度が速く、安価に加工できるため工業的に用いるには最も適しており、本願発明に最も望ましいレーザ加工機である。

ここで、炭酸ガスレーザ加工機を用いた場合には、該穴40 a内であって、金属層42の表面にわずかながら溶融した樹脂が残りやすいため、デスミア処理
5 することが、接続信頼性を確保するため望ましい。

引き続き、レーザ加工で開けた非貫通孔40 aに電解めっきを充填してパイアホール36 aとする（工程（E））。なお、電解めっきを一部充填し残存部分に導電性ペーストを充填して行うこともできる。

10 電解めっきとしては、例えば、銅、金、ニッケル、ハンダめっきを使用できるが、特に、電解銅めっきが最適である。この場合は、バンプを同時に形成することができる。

導電性ペーストは、銀、銅、金、ニッケル、半田から選ばれる少なくとも1種以上の金属粒子からなる導電性ペーストを使用できる。また、前記金属粒子
15 としては、金属粒子の表面に異種金属をコーティングしたものも使用できる。具体的には銅粒子の表面に金、銀から選ばれる貴金属を被覆した金属粒子を使用することができる。

なお、導電性ペーストとしては、金属粒子に、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂、ポリフェニレンスルフィド（PPS）などの熱可塑性
20 樹脂を加えた有機系導電性ペーストが望ましい。

本実施態様では、レーザ加工にて孔径20～150 μm の微細径の孔を穿設し、電解めっきを充填するが、導電性ペーストを充填する場合に比べて気泡が抜けやすく有利である。

電解めっきは、絶縁基材40に形成された金属層42をめっきリードとして
25 行う。前記金属層42は、絶縁基材40上の全面に形成されているため、電界密度が均一となり、非貫通孔を電解めっきにて均一な高さで充填することができる。この実施態様では、電解めっきにより非貫通孔を完全充填する。ここで、電解めっき前に、非貫通孔40 a内の金属層42の表面を酸などで活性化処理しておくといよい。めっきを行う際には、絶縁基材40に形成された金属層42
30 の表面側に電解めっきが析出しないように、工程（C）に示すよう金属層42

- 11 -

側にマスク48をかけておくか、或いは、工程(D)に示すように同じ絶縁基材40を2枚、金属層42同士を積層密着させてめっき液に触れないようにして、電解めっきを行ことが好ましい。

電解めっきした後、第4図の工程(F)に示すように孔40aから盛り上がった電解めっき(金属46)を研磨などで除去して、平坦化することもできる。5 研磨は、ベルトサンダーやバフ研磨等を使用できる。

工程(G)に示すように、金属層42をエッチングして導体回路を形成するための前処理として、ファインパターンを形成しやすくするため、あらかじめ、非貫通孔をレーザ加工にて形成した後に金属層42の表面側の全面をエッチングして厚さを1~10 μ m、より好ましくは2~8 μ m程度まで薄くすることが10 できる。

工程(H)に示すように、所定パターンのマスクを披覆した後、金属層42をエッチングして導体回路32aを形成する。ここでは、先ず、感光性ドライフィルムを貼付するか、液状感光性レジストを塗布した後、所定の回路パターンに沿って露光、現像処理してエッチングレジストを形成した後、エッチング15 レジスト非形成部分の金属層をエッチングして導体パターンを形成する。エッチングは、硫酸-過酸化水素、過硫酸塩、塩化第二銅、塩化第二鉄の水溶液から選ばれる少なくとも1種がよい。

なお、最外層のパターンについては、積層プレス後に金属層をエッチングして形成することもできる。積層後に金属層をエッチングする場合は、プレス面20 が平坦なため、均一な圧力で熱プレスできるという利点がある。

なお、導体回路32aの表面は、粗化处理しておくことが望ましい。第1図を参照して上述した接着剤層34との密着性を改善し、剥離(デラミネーション)を防止するためである。粗化处理は、例えばソフトエッチング処理や、黒化(酸化)-還元処理、銅-ニッケル-リンからなる針状合金めっき(荏原ユージライト製 商品名インタープレート)の形成、メック社製の商品名「メックエッチボンド」なるエッチング液による表面粗化がある。25

次に、工程(I)にて、導体回路32aを形成した面とは反対側の、パイアホール36a表面にバンプ38aを形成する。バンプ38aは、例えば、導電性ペーストを所定位置に開口の設けられたメタルマスクを用いてスクリーン印30

刷する方法、低融点金属である半田ペーストを印刷する方法、半田めっきを行う方法、あるいは半田溶解液に浸漬する方法により形成することができる。

前記低融点金属としては、Pb-Sn系半田、Ag-Sn系半田、インジウム半田等を使用することができる。

- 5 前記バンプの絶縁基材40からの高さとしては、3～60 μm が望ましい。この理由は、3 μm 未満では、バンプの変形により、バンプの高さのばらつきを許容することができず、また、60 μm を越えると抵抗値が高くなる上、バンプを変形した際に横方向に拡がってショートの原因となる。

- この状態で、もしくは、バンプを形成する前に、導体回路32a、パイアホール36aの検査が可能である。上述したように従来技術の多層プリント配線板では、積層して完成後でなければ、導体回路の検査を行えなかったのに対して、本実施態様では、片面回路基板30Aを、積層する前に不良個所の有無を検査することかでき、後述する積層段階では、不良のない片面回路基板30Aのみを用いることができるので、多層プリント配線板としての高い歩留まりが
15 得られる。

- 本発明の片面回路基板は、複数の片面回路基板を相互に積層接着したり、第2図に示したコア基板20に積層接着される。この場合の接着剤は、例えば、工程(J)に示すように、該絶縁基材40のバンプ38a側の表面全面に、樹脂を塗布して、乾燥することにより、未硬化樹脂からなる接着剤層34が形成
20 される。

接着剤層34は、片面回路基板の導体回路形成面もしくは、その反対側面、または、導体回路を有するコア基板20の導体回路25の形成面のいずれか全面に塗布して形成することができ、接着剤層に導通のための孔明けの必要がない。

- 25 接着剤層34は、有機系接着剤からなることが望ましく、有機系接着剤としては、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、熱硬化型ポリフェノレンエーテル(PPE: Polyphenylene ether)、エポキシ樹脂と熱可塑性樹脂との複合樹脂、エポキシ樹脂とシリコン樹脂との複合樹脂、BTレジンから選ばれる少なくとも1種の樹脂であることが望ましい。

- 30 有機系接着剤である未硬化樹脂の塗布方法は、カーテンコータ、スピンコー

タ、ロールコータ、スプレーコート、スクリーン印刷などを使用できる。また、接着剤層の形成は、接着剤シートをラミネートすることによってもできる。接着剤層の厚さは、 $5 \sim 50 \mu\text{m}$ が望ましい。接着剤層は、取扱が容易になるため、予備硬化（プレキュア）しておくことが好ましい。

- 5 引き続き、第2図を参照して上述したコア基板20と、第3図及び第4図を参照して上述した片面回路基板30との積層工程について第5図を参照して説明する。

- 工程（K）に示すように、該片面回路基板30Aと、上述したと同様な工程で形成された片面回路基板30B、30C、30Dと、コア基板20とを積み重ねる。ここで、全ての片面回路基板30A、30B、30C、30D、及びコア基板20は、不良個所の検査が済んだものを用いる。先ず、片面回路基板30Aの有機系接着剤層34の上に片面回路基板30Bを、又、該片面回路基板30Bの有機系接着剤層34の上にコア基板20を載置する。ここで、該コア基板の上には、片面回路基板30C、30Dを反転、即ち、片面回路基板30Cの有機系接着剤層34が該コア基板20側へ向き、又、片面回路基板30Dの有機系接着剤層34が該片面回路基板30C側に向くように重ね合わせる。この重ね合わせは、片面回路基板30及びコア基板20の周囲に設けられたガイドホール（図示せず）をガイドピン（図示せず）に挿通することで位置合わせしながら行う。ここで、積層された基板の図中サイクルCの部分を拡大して（M）として示す。また、位置合わせは、画像処理にて行ってもよい。

- 最後に、工程（L）に示すように、重ね合わせた基板を、熱プレスを用いて $150 \sim 200^\circ\text{C}$ で加熱し、 $5 \sim 100 \text{ kgf/cm}^2$ 、望ましくは $20 \sim 50 \text{ kgf/cm}^2$ で加圧プレスすることにより、各片面回路基板30A、30B、30C、30Dおよびコア基板20を、1度のプレス成形により多層状に一体化する。積層された基板の図中サイクルCの部分を拡大して（N）として示す。ここでは、先ず、加圧されることで、該片面回路基板30Aの bumps 38aが、該 bumps 38aと片面回路基板30B側の導体回路32bとの間に介在している未硬化の接着剤（絶縁性樹脂）を周囲に押し出し、該 bumps 38aが導体回路32bと、当接し両者の接続を取る。同様に他の片面回路基板30B、30C、30Dの bumps 38b、38c、38dと導体回路との接続が取

- 14 -

られる。更に、加圧と同時に加熱されることで、片面回路基板 30 A の接着剤層 34 が硬化し、片面回路基板 30 B との間で強固な接着が行われる。なお、熱プレスとしては、真空熱プレスを用いることが好適である。これにより第 1 図を参照して上述した多層プリント配線板 10 が完成する。

5 ついで、別の実施態様について第 7 図に沿って説明する。

第 7 図の工程 (A) において用意された片面銅張積層板 40 に、工程 (B) に示すように、主として導電ペーストの印刷用のマスクとして使用される保護フィルム 100 を貼付し、工程 (C) にてこの片面銅張積層板 40 にレーザ加工を施して非貫通孔を設ける。この保護フィルム 100 としては、例えば表面
10 に粘着層を設けたポリエチレンテレフタレートフィルム (PET) を使用できる。金属層 42 にめっきが析出しないように、工程 (D) のように保護フィルム 48 を貼付するか、工程 (E) のように金属層 42 同士を密着させて、電解めっき液に接触しないようにし、工程 (F) において、この非貫通孔の一部を電解めっき 46 で充填する。さらに工程 (G) において、残りの空間に導電性
15 ペースト 460 を充填する。このような実施形態では、電解めっきの高さのばらつきを導電ペースト 460 により是正してバンプの高さをそろえることができる。なお、この場合導電性ペーストの代えて低融点金属を充填することもできる。

前記電解めっきの非貫通孔の充填率 (電解めっきの高さ $t \times 100 /$ 非貫通孔の深さ T : 第 8 図の L 参照) は、平均で 50 % 以上、100 % 未満、より好ましくは、55 % ~ 95 % であり、60 % ~ 90 % が最適である。

前記保護フィルム 100 の開口に充填された導電ペースト 460 は、バンプとなる。さらに、工程 (H) にて導電性ペースト 460 を保護するフィルム 101 を貼付して金属層 42 をエッチングして導体回路を設ける。工程 (I) に
25 てフィルム 101 を除去して、導電性ペースト 460 で形成されたバンプを露出させ、本発明の片面回路基板 30 E を得る。

前記導電ペーストからなるバンプは、半硬化状態であることが望ましい。導電ペーストは、半硬化状態でも硬く、熱プレス時に軟化した有機接着剤層を貫通させることができる。また、プレス時に変形して接触面積が増大し、導通抵抗を低くすることができるだけでなく、バンプの高さのばらつきを是正するこ
30

とができる。なお、バイアホールおよびバンプ部分の構造の写真を第9図に記載する。

さらに工程(A)～(I)にて得られた片面回路基板30Eを工程(J)にて、中心に接着剤層80を介して3層ずつ対向する向きに積層する。この重ね合わせは、片面回路基板30及びコア基板20の周囲に設けられたガイドホール(図示せず)をガイドピン(図示せず)に挿通することで位置合わせしながら行う。また、位置合わせは、画像処理にて行ってもよい。

さらに熱プレスして工程(K)に示すような多層プリント配線板10を製造するのである。

10 上述した実施態様では、4層および6層の片面回路基板30が重ね合わされた多層プリント配線板を例にとり説明したが、3層あるいは5層以上の多層プリント配線板にも本発明の片面回路基板を使用できる。更に、従来技術の方法で作成された片面プリント基板、両面プリント基板、両面スルーホールプリント基板、多層プリント基板等に本発明の片面回路基板を積層して多層プリント
15 配線板を製造することもできる。

また、上述した実施態様では、バイアホールを形成するための穴をレーザ加工を用いて形成したが、ドリル加工、パンチング加工等の機械的方法で穴開けすることも可能である。

また、本発明の片面回路基板を用いて製造された多層プリント配線板は、プリント配線板に一般的に行われている種々の加工処理、例えば、表面へのソルダーレジストの形成、表面の導体回路へのニッケル/金めっきやハンダ処理、穴開け加工、キャビティ加工、スルーホールめっき処理等を施すことができる。

以上のように、本発明によれば、所定の配線パターンを形成した導体回路を有する片面回路基板が、予め個々に製造される。このため、該片面回路基板を積層する前に、導体回路等の不良個所の有無を検査することで、積層段階では、不良のない片面回路基板のみを用いることが可能となる。即ち、本発明の片面回路基板を用いることにより、製造段階での不良発生が少なくなり、IVH構造の多層プリント配線板を高い歩留まりで製造できる。

30 また、本発明の片面回路基板を用いることにより、従来技術のようにプリブ

- 16 -

レグを積み重ねながら熱プレスを繰り返す必要がない。即ち、片面回路基板を複数枚重ねて、該片面回路基板に配設された接着剤層を介して、1度に熱プレスすることができる。このため、複雑な熱プレス工程を繰り返す必要がなく、I V H構造の多層プリント配線板を短時間で効率良く製造することができる。

- 5 さらに、1回のプレスにより物理的な力で一体化しているため、接続信頼性にも優れている。

- さらに、本発明では、片面回路基板を製造するにあたり、絶縁性基板の非貫通孔の形成は、レーザ加工により行うのであるが、接着剤層にレーザ加工で孔明けする必要がなく、絶縁性基材と接着剤層を同時にレーザ加工で孔明けしなくともよい。つまり、絶縁性基板をレーザ加工で孔明けした後、片面回路基板もしくは導体回路を有する基板に接着剤層を形成できるのである。このため、孔明け後のデスミア処理を接着剤層の形成前に実施することができることになり、デスミア処理により接着剤層が浸食されることがない。

- また、非貫通孔を電解めっきを充填する場合は、絶縁性基板にレーザ加工にて非貫通孔を形成、電解めっき充填後に、片面回路基板もしくは導体回路を有する基板に接着剤層を形成できるため、電解めっき液と接着剤層が接触することはない。従って、めっき液により接着剤層が浸食されることがない。

- 接着剤層は、最終工程の熱プレスに至るまでは未硬化であるため、デスミア処理やめっき液で劣化しやすいが、本願発明では、このような問題の発生を防止し、信頼性の高い基板を容易に形成できるという特徴を持つ。

- また、本発明の片面回路基板において、絶縁性基材の非貫通孔に、電解めっきを充填してバイアホールを形成するとともに、前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側のバイアホールの表面には、導電ペーストあるいは低融点金属にて突起状導体を形成するため、熱プレスの際に導電ペーストあるいは低融点金属が変形して電解めっきの高さのばらつきを吸収することができるため、接続不良を防止して接続信頼性に優れた多層プリント配線板が得られる。

さらに、本発明では、接着剤層に予め導通のための孔を形成しておく必要はないため、接着剤層の孔と有機系絶縁基板に設けた突起状導体との位置ずれにより導通不良を起こすことがない。

- 30 また、本発明では、電解めっきで充填されたバイアホール上に導電性ベース

- 17 -

- トあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成するため、多層プリント配線板における上下導体層の層間の電気的な接続は、比較的薄い有機系接着剤層のみを貫通させて行えば足りる。それ故、突起状導体の高さを低く、またその径を小さくできるため、突起状導体のピッチ間隔を小さくでき、高密度化に対応
- 5 できる。

請求の範囲

1. 絶縁性基材の一方の面に導体回路を形成してなり、かつ前記絶縁性基材には導体回路に至る非貫通孔を設け、その非貫通孔に、電解めっきを充填してバイアホールを形成するとともに、前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側のバイアホールの表面には、導電性ペーストあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成したことを特徴とする片面回路基板。
2. 前記非貫通孔は、電解めっきにより完全に充填されてなる請求の範囲 1 に記載の片面回路基板。
3. 前記非貫通孔は、電解めっきにより、平均でその非貫通孔の深さの 50 % 以上、100 % 未満充填されてなる請求の範囲 1 または 2 に記載の片面回路基板。
4. 前記絶縁性基材は、有機系絶縁性基材である請求の範囲 1 ~ 3 のいずれか 1 つに記載の片面回路基板。
5. 前記電解めっきは、電解銅めっきである請求の範囲 1 ~ 4 のいずれか 1 つに記載の片面回路基板。
6. 前記絶縁性基材は、片面銅張積層板である請求の範囲 1 ~ 5 のいずれか 1 つに記載の片面回路基板。
7. 以下の (1) ~ (4) の工程を少なくとも含む片面回路基板の製造方法、
 - (1) 一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属層に至る非貫通孔をレーザ加工にて形成する工程、
 - (2) (1) で形成された非貫通孔に電解めっきを充填してバイアホールを形成する工程、
 - (3) 金属層をエッチングして導体回路を形成する工程、
 - (4) 前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側のバイアホールの表面に導電性ペーストあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成して片面回路基板とする工程。
8. 以下の (1) ~ (3) の工程を少なくとも含む片面回路基板の製造方法、
 - (1) 一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属層に至る非貫通孔をレーザ加工にて形成する工程、
 - (2) (1) で形成された非貫通孔に電解めっきを充填してバイアホールを

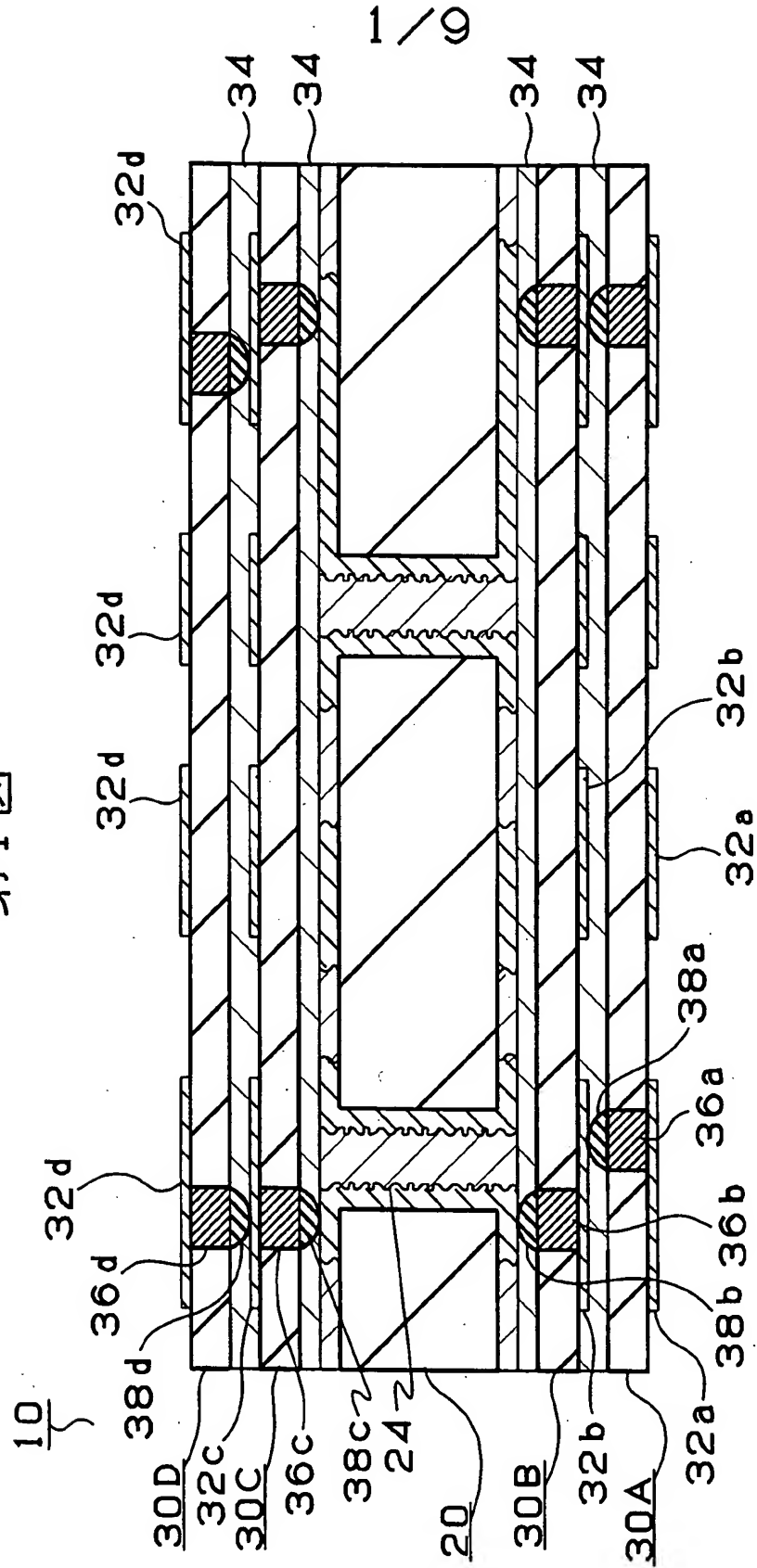
- 19 -

形成した後、前記絶縁性基材の導体回路を形成した面の反対側のバイアホールの表面に導電性ペーストあるいは低融点金属からなる突起状導体を形成する工程、

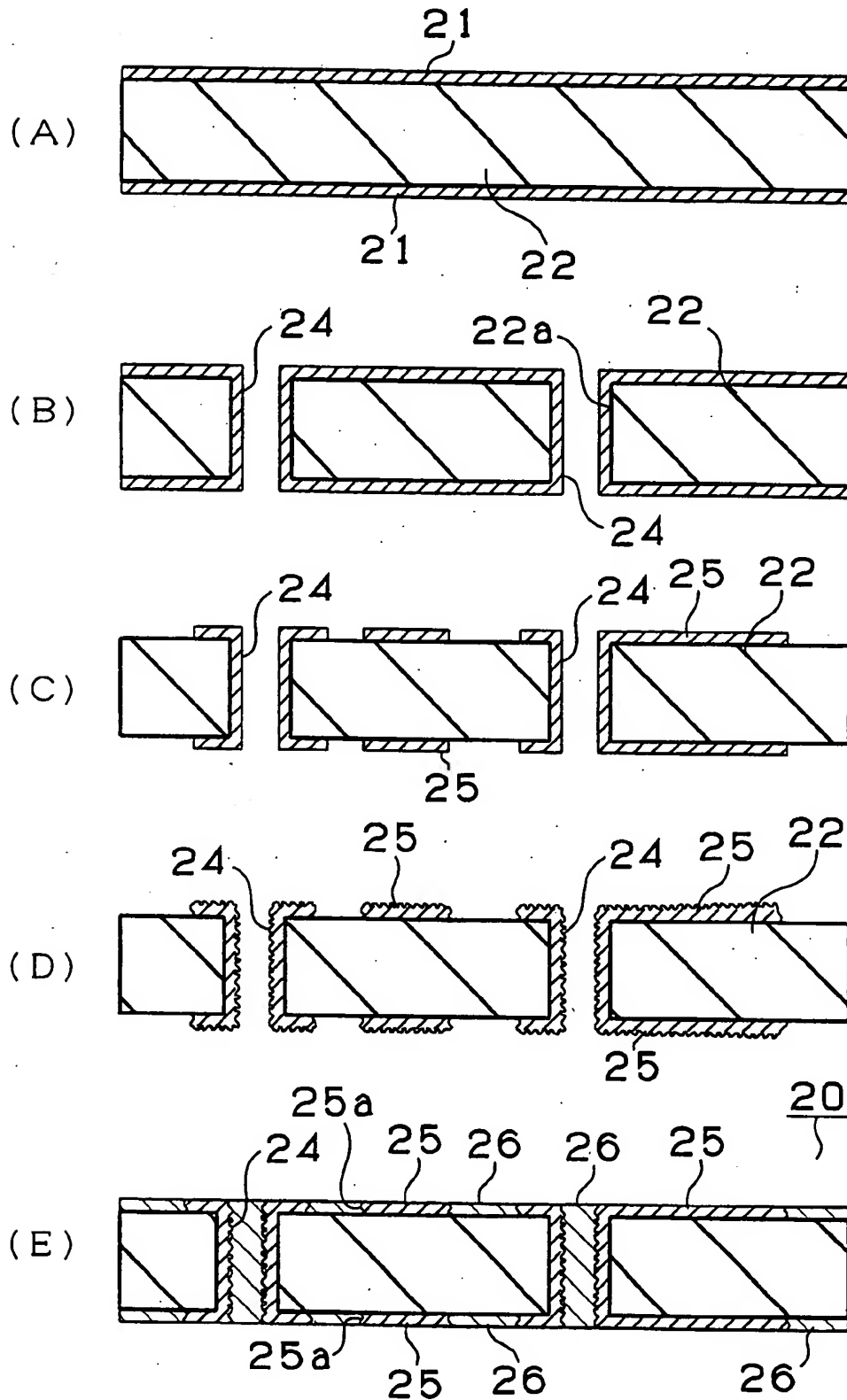
(3) 金属層をエッチングして導体回路を形成して片面回路基板とする工程。

- 5 9. 前記(1)の工程において、一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、フィルムを貼付し、該フィルムおよび絶縁性基材を貫通して該金属層に至る非貫通孔をレーザ加工にて形成する請求の範囲7または8に記載の片面回路基板の製造方法。
- 10 10. 前記絶縁性基材は、有機系絶縁性基材である請求の範囲7～9のいずれか1つに記載の片面回路基板の製造方法。
11. 前記絶縁性基材は、片面銅張積層板である請求の範囲7～10のいずれか1つに記載の片面回路基板の製造方法。
12. 前記電解めっきは、電解銅めっきである請求の範囲7～11のいずれか1つに記載の片面回路基板。
- 15 13. 前記突起状導体は、導電性ペーストを印刷することにより形成する請求の範囲7～12のいずれか1つに記載の片面回路基板の製造方法。
14. 前記突起状導体は、低融点金属ペーストの印刷、低融点金属のめっき、または低融点金属の熔融液への浸漬により形成する請求の範囲7～13のいずれか1つに記載の片面回路基板の製造方法。

第1図

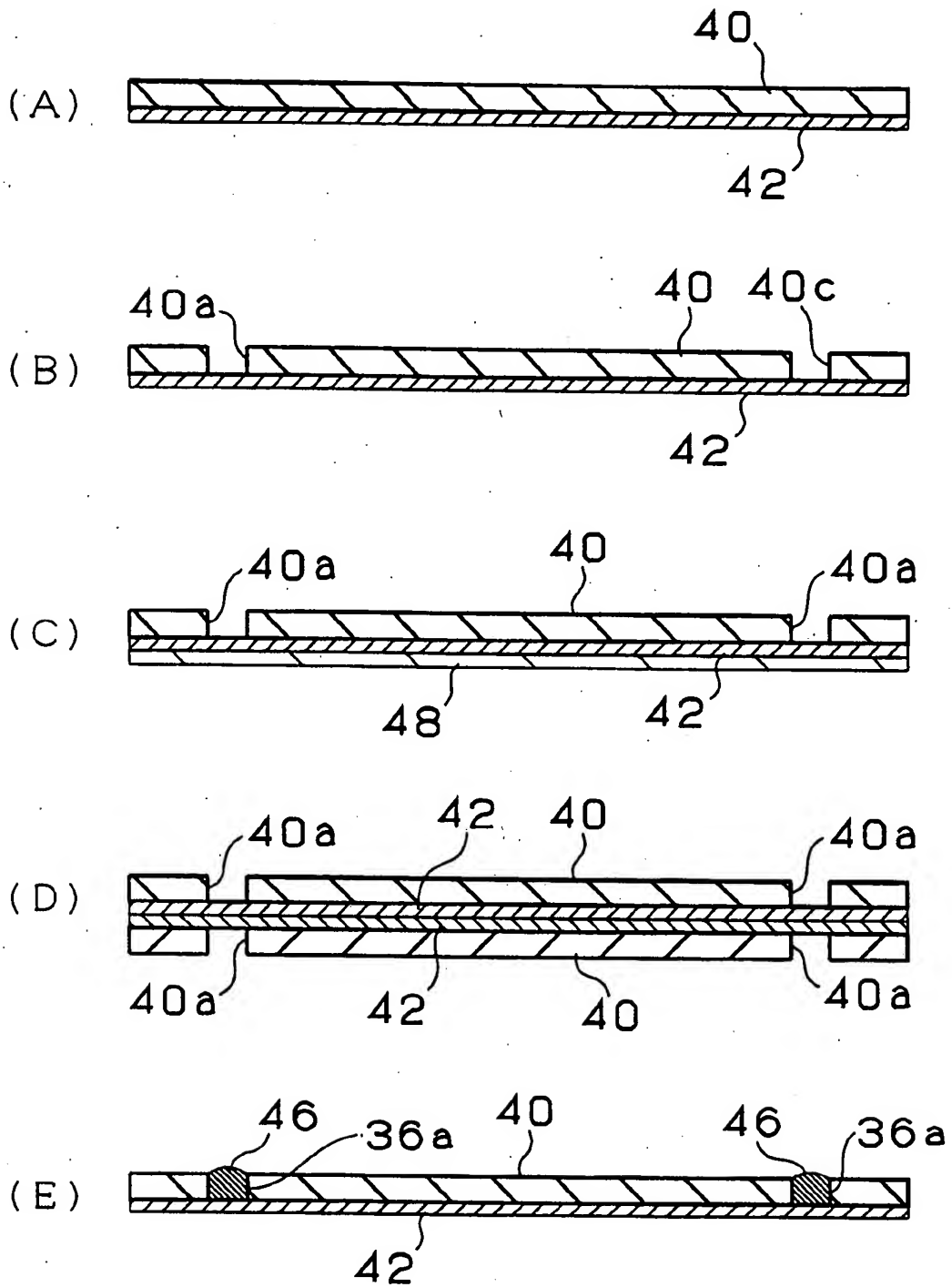


2/9
第2図



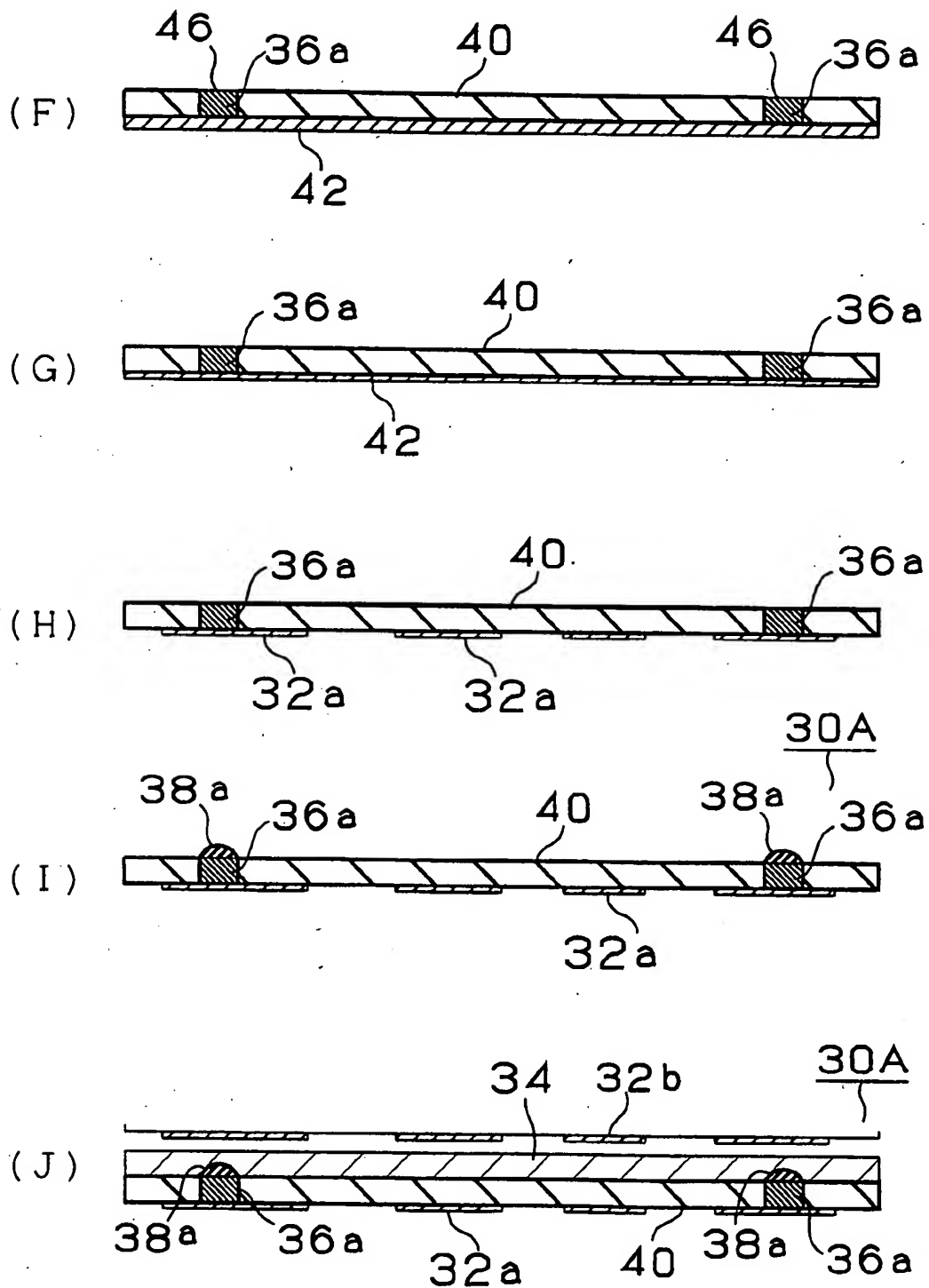
3/9

第3図



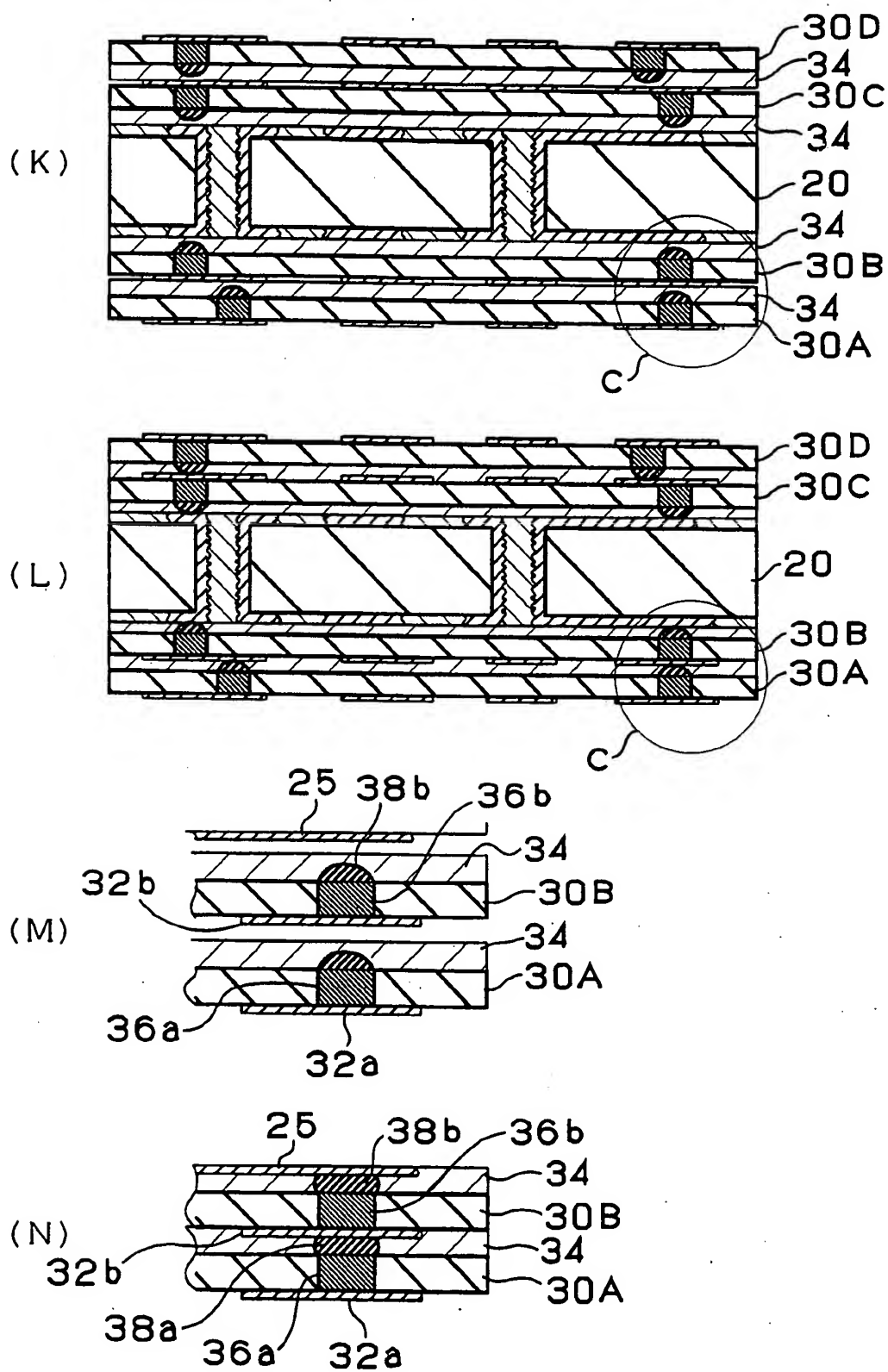
4/9

第4図

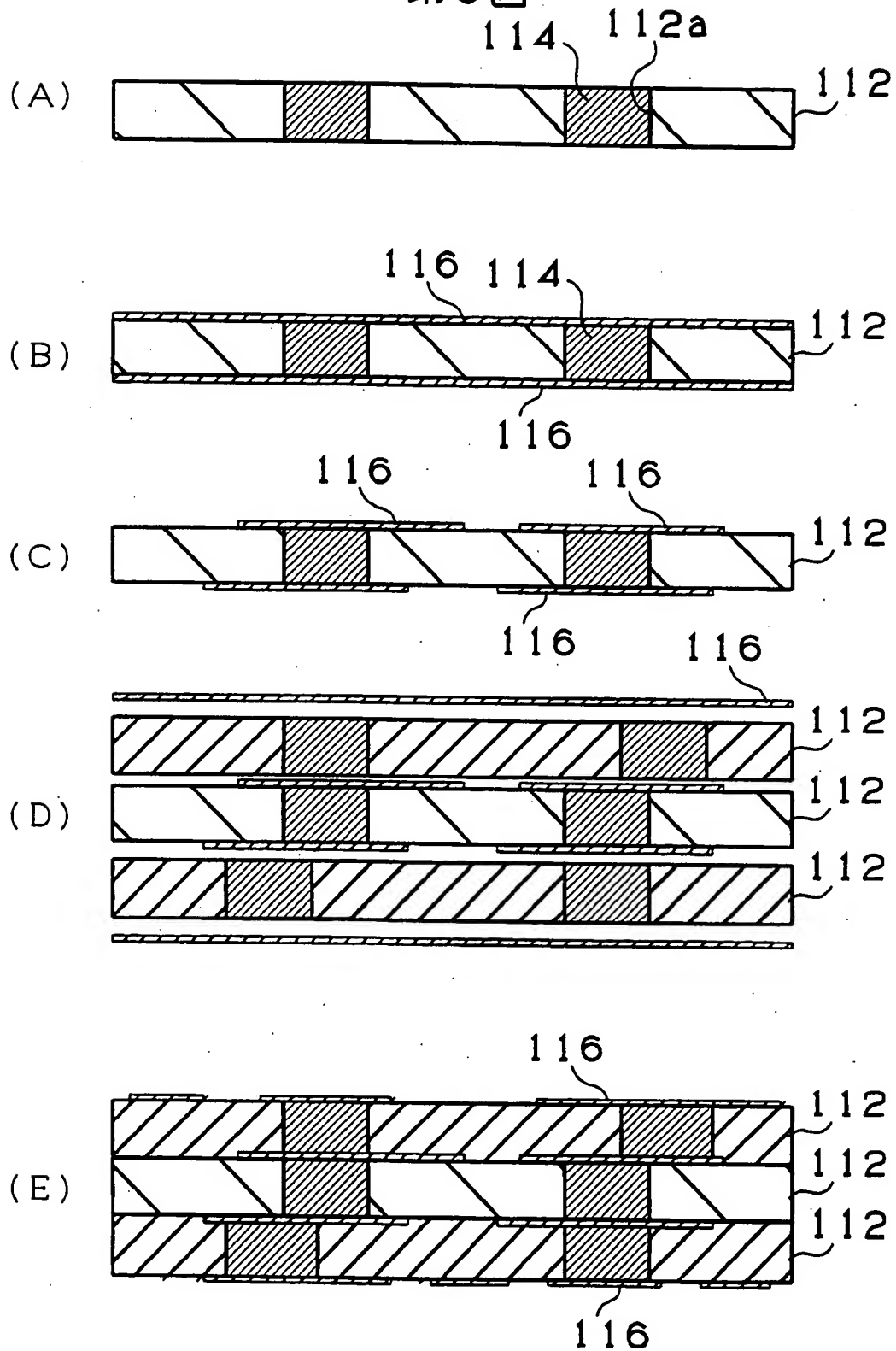


5/9

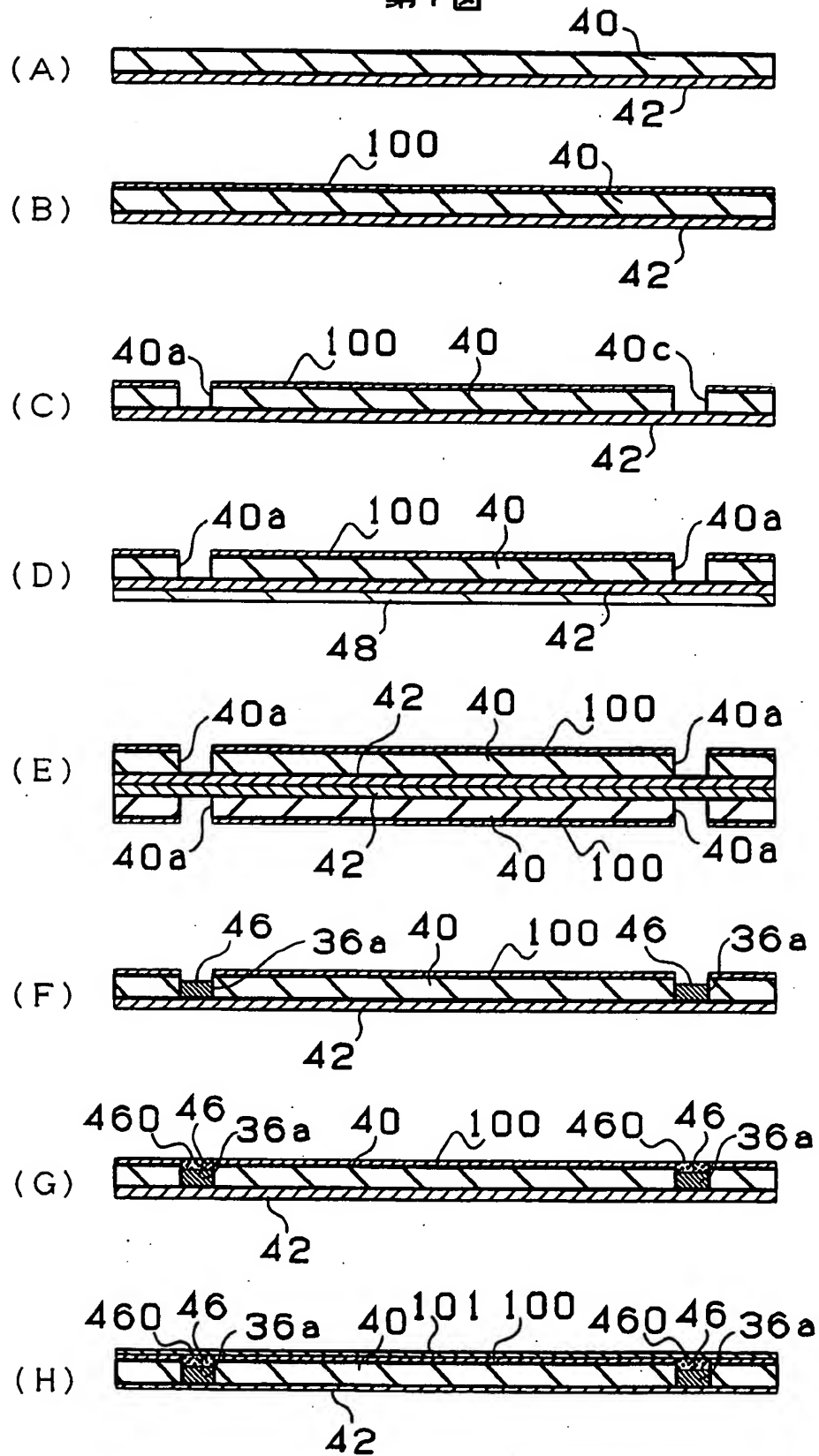
第5図



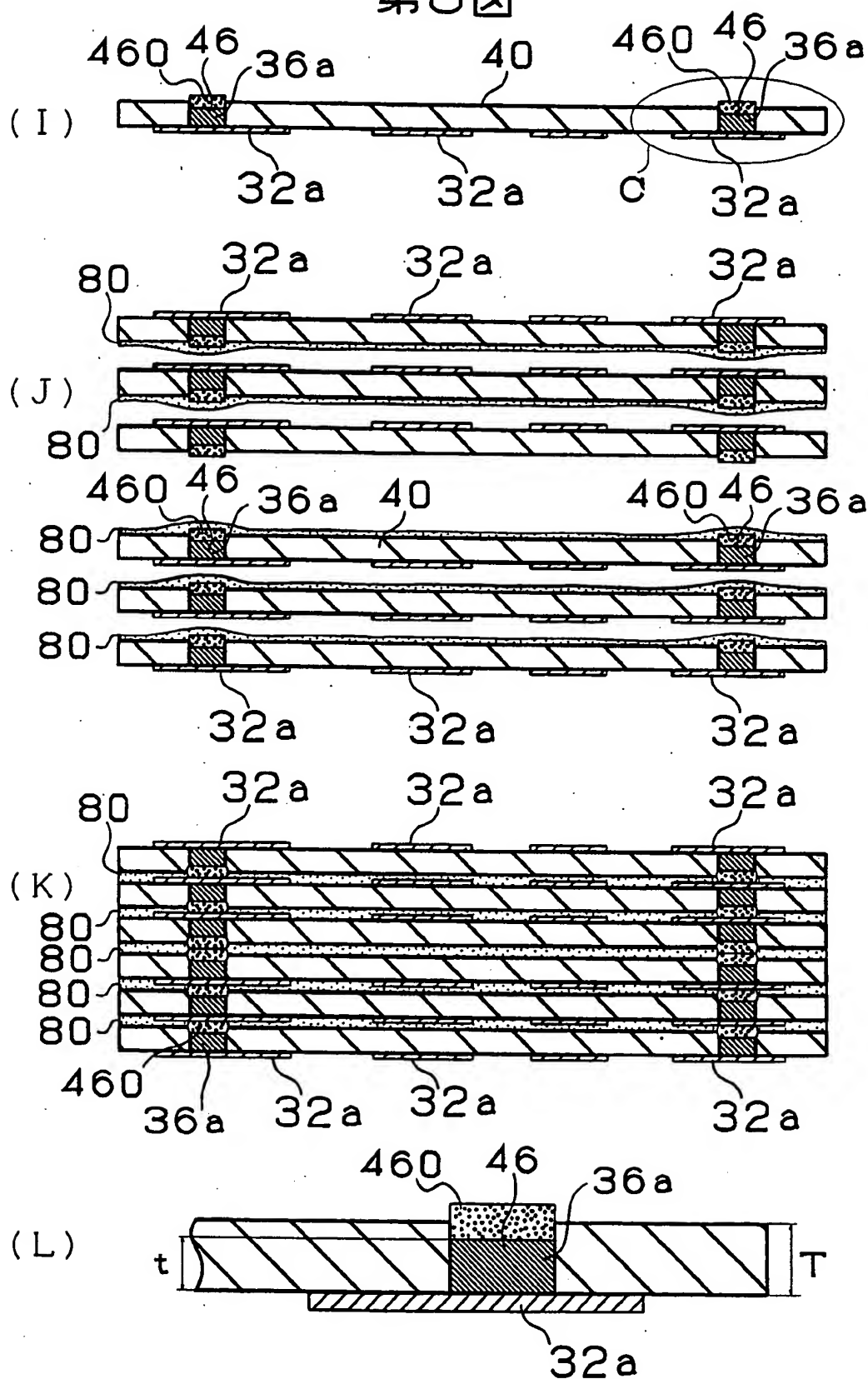
6/9
第6図



7/9
第7図

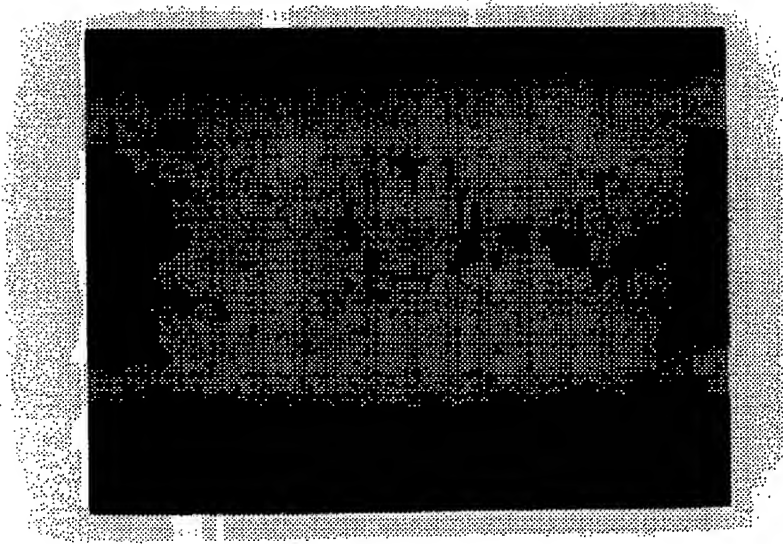


8/9
第8図



9/9

第9図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/02498

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁶ H05K3/46, H05K3/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁶ H05K3/46, H05K3/00, H05K3/40, H05K1/11

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 6-326438, A (Nitto Denko Corp.), November 25, 1994 (25. 11. 94), Par. Nos. [0029], [0030] (Family: none)	1-14
E, X	JP, 10-117067, A (Shinko Electric Industries Co., Ltd.), May 6, 1998 (06. 05. 98), Par. Nos. [0009] to [0014] (Family: none)	1-14
A	JP, 4-162589, A (NEC Corp.), June 8, 1992 (08. 06. 92) (Family: none)	1-14

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
August 18, 1998 (18. 08. 98)

Date of mailing of the international search report
August 25, 1998 (25. 08. 98)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP98/02498

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl⁶ H05K3/46, H05K3/40

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl⁶ H05K3/46, H05K3/00, H05K3/40, H05K1/11

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-1998年
 日本国登録実用新案公報 1994-1998年
 日本国実用新案登録公報 1996-1998年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 6-326438, A (日東電工株式会社) 25. 11月. 1994 (25. 11. 94) 段落【0029】-【0030】 (ファミリーなし)	1-14
E, X	JP, 10-117067, A (新光電気工業株式会社) 6. 5月. 1998 (06. 05. 98) 段落【0009】-【0014】 (ファミリーなし)	1-14

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

18. 08. 98

国際調査報告の発送日

25.08.98

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

大畑 通隆

4E

9443

電話番号 03-3581-1101 内線 3427

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 4-162589, A (日本電気株式会社) 8. 6月. 1992 (08. 06. 92) (ファミリーなし)	1-14